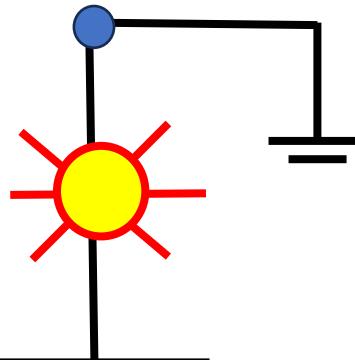


High Energy Ion 打ち込み工程の追加以外は、
従来の格安シングル接合型太陽電池と
製法は全く同一で生産できます。

- $V_{out} < 0$



```
+++++++
Vout=0.500000 RN=0.600000 としています。
+++++++
+++++++
DP=100,00000 の場合：
VBP=0.324852
VMAX=EG-VBP-Vout=0.285148
DNS=430,800000
A=DNS/DP=4,308000
QN=DNS*RN*RPI=458,143678
VV=DNS*RN/RN/Esi=0.239333
XJ=RN*log(sqrt(A))=0.725100
WWD=2*WD=2*y*RN=4.581438
VM=-VV*W=0.285225
XJJ=WD+XJ=3.015820
+++++++
一番理想的なWAFERは、100Ωmの高抵抗基板です。
その場合は、RN=0.6μm, XJJ=3.015820 μmの深さで
リンのドーズ量 QN=4.58143678 x 10 の 10乗 per cm の2乗 です。
空乏層幅WWD=4.581438 μmとなりそれ相当の光電変換率が期待されます。
+++++++

```

合同会社Locomtec/萩原aips研究所

<https://locomtec.jp/harl-1>

